PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-149796

(43) Date of publication of application: 02.06.1998

(51)Int.CI.

H01J 61/06 H01J 61/073

(21)Application number : 08-306650

(71)Applicant: HAMAMATSU PHOTONICS KK

KOBE STEEL LTD

(22) Date of filing:

18.11.1996

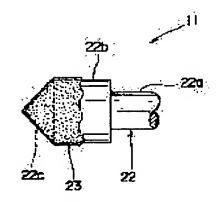
(72)Inventor: WARASHINA HIDENAGA

YOKOTA YOSHIHIRO

(54) DISCHARGE TUBE, AND ELECTRODE FOR DISCHARGE TUBE (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the sufficient electron emitting ability of a positive electrode or a negative electrode, and to improve the stability of output of the pulse light to be radiated outside at the time of discharge by coating a surface of an electrode base material with a diamond thin film, a diamond-like carbon thin film or a carbon thin film.

SOLUTION: A negative electrode 11 has a cylindrical part 22b at a tip of a narrow bar-like supporting part 22a thereof, and furthermore, a tip of the cylindrical part 22b is provided with a conical part 22c so as to efficiently discharge electron. The supporting part 22a, the cylindrical part 22b and the conical part 22c form an electrode base material 22, and this



electrode base material 22 is formed of an electrode base material made of tungsten, for example, having the fine structure. The conical part 22c of the electrode base material 22 is coated with a diamond thin film at 0.1-10μm of thickness. With this structure, a difference of optical intensity between the pulse light, which are radiated out of a discharge tube at the time of discharge in order of lapse of time, is reduced, and stability of optical output is improved.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.08.2001

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-149796

(43)公開日 平成10年(1998)6月2日

(51) Int.Cl.⁶

H01J 61/06

識別記号

FΙ

H01J 61/06

Н

61/073

61/073

Н

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特額平8-306650

(22)出顧日

平成8年(1996)11月18日

(71)出頭人 000236436

浜松ホトニクス株式会社

静岡県浜松市市野町1126番地の1

(71)出願人 000001199

株式会社神戸製鋼所

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

(72)発明者 藁科 英永

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ

トニクス株式会社内

(72)発明者 横田 嘉宏

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号

株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内

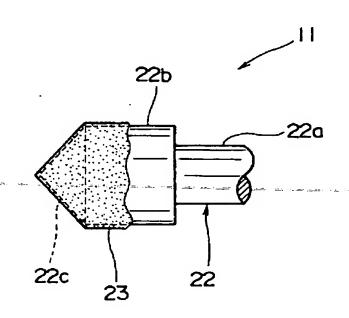
(74)代理人 弁理士 長谷川 芳樹 (外3名)

(54) 【発明の名称】 放電管および放電管用電極

(57)【要約】

【課題】 光出力の安定性を改善した放電管および放電 管用電極を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明の放電管用電極11,12は、密封容器9内で一対となって対向配置される放電管用電極において、電極基材22の表面にダイヤモンド薄膜23がコーティングされている構成であり、本発明の放電管1は、一対の放電管用電極11,12のうち少なくとも一方がダイヤモンド薄膜23をコーティングした放電管用電極となっている構成である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 密封容器内で一対となって対向配置され る放電管用電極において、電極基材の表面にダイヤモン ド薄膜がコーティングされていることを特徴とする放電 管用電極。

1

【請求項2】 密封容器内で一対となって対向配置され る放電管用電極において、電極基材の表面にダイヤモン ド状カーボン薄膜がコーティングされていることを特徴 とする放電管用電極。

【請求項3】 密封容器内で一対となって対向配置され る放電管用電極において、電極基材の表面にカーボン薄 膜がコーティングされていることを特徴とする放電管用 電極。

【請求項4】 密封容器内で一対となって対向配置され る放電管用電極において、電極基材の表面に、炭化タン グステン、炭化モリブデン、炭化ハフニウム及び炭化タ ンタルからなる群より選ばれる少なくとも一種類の材料 からなる膜が形成されていることを特徴とする放電管用

ⅠⅠⅠ族又はⅤ族の元素がドープされていることを特徴 とする請求項1記載の放電管用電極。

【請求項6】 前記ダイヤモンド状カーボン薄膜には不 純物としてIII族又はV族の元素がドープされている ことを特徴とする請求項2記載の放電管用電極。

【請求項7】 前記電極基材の表面が円錐状であること を特徴とする請求項1~6のいずれか一項に記載の放電 管用電極。

【請求項8】 前記電極基材は、モリブデン又はタング ステンからなる電極母材であることを特徴とする請求項 1~7のいずれか一項に記載の放電管用電極。

【請求項9】 前記電極基材は、タングステンからなる 電極母材の表面に、モリブデン、ハフニウム及びタンタ ルからなる群より選ばれる少なくとも一種類の材料から なる膜をコーティングして構成されていることを特徴と する請求項1~7のいずれか一項に記載の放電管用電 極。

【請求項10】 一密封容器内で一対の放電管用電極を配 -置させる放電管において、前記一対の放電管用電極のう ち少なくともいずれか一方が、請求項1~9のいずれか 一項に記載の放電管用電極であることを特徴とする放電 管。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、分光、発光分析な どの光源として用いられる放電管および放電管用電極に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来からある放電管として、例えばパル

フラッシュランプは、不活性ガスを封入したガラス製の バルブ内に、先端を円錐状にした陽極と、これと同一形 状の陰極とを互いに向き合わせて配置させている。ま た、陽極と陰極との間に、針状のトリガプローブ電極の 先端が配置されている。そして、陽極と陰極との間に適 当な電圧を印加した状態でトリガプローブ電極にそれぞ れトリガ電圧を印加すると、陰極と陽極との間にアーク 放電が生成され、その放電に伴って外部にパルス光が放 射される。

【0003】とのフラッシュランプに使用される陰極及 び陽極は、以下のようにして製造される。すなわち、陰 極及び陽極は、平均粒径1 u~8 uのタングステン等の 粉末をブレス成形したものを、真空中で2000℃~2 600℃で焼結して5%~45%の空孔率をもった多孔 質金属からなる電極本体を形成し、この電極本体にアル ミン酸アルカリ土類からなる電子放射物質を含浸させて 製造されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し 【請求項5】 前記ダイヤモンド薄膜には不純物として 20 た従来からあるフラッシュランプは、特に、高い再現性 が要求される分析装置又は精密なタイミングでの発光が 要求される分析装置に適用させる場合には、前述のよう にして製造された陽極又は陰極の電子放出能が十分では なく、外部に放射されるパルス光出力の安定性が十分で はない。

> 【0005】本発明は、前述した従来の問題点に鑑みて なされたもので、光出力の安定性を改善した放電管およ び放電管用電極を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】前述した問題点を解決す るために、本発明による放電管用電極は、密封容器内で 一対となって対向配置される放電管用電極において、電 極基材の表面に、ダイヤモンド薄膜、ダイヤモンド状カ ーボン薄膜又はカーボン薄膜がコーティングされている ことを特徴とする。この放電管用電極によれば、密封容 器内の一対の電極本体間に適当な電圧を印加して放電を 起とさせる場合に、ダイヤモンド薄膜、ダイヤモンド状 _カーボン薄膜又はカーボン薄膜から電子が放出され易く なり、放電時に発生する光出力の安定性が改善される。 【0007】また、前述した電極基材の表面には、炭化 タングステン、炭化モリブデン、炭化ハフニウム及び炭 化タンタルからなる群より選ばれる少なくとも一種類の 材料からなる膜が形成されていてもよい。

【0008】また、ダイヤモンド薄膜又はダイヤモンド 状カーボン薄膜には不純物としてIII族又はV族の元 素がドープされていることが好ましく、さらに電極基材 の表面は円錐状であることが好ましい。なお、電極基材 は、モリブデン又はタングステンからなる電極母材であ ることが好ましい。

ス点灯型の放電管であるフラッシュランプがある。との 50 【0009】また、電極基材は、タングステンからなる

電極母材の表面に、モリブデン、ハフニウム及びタンタ ルからなる群より選ばれる少なくとも一種類の材料から なる膜をコーティングして構成されていることが好まし い。この場合、電極母材と、ダイヤモンド薄膜、ダイヤ モンド状カーボン薄膜又はカーボン薄膜との密着性を向 上させることができ、ひいては放電管用電極の寿命を延 ばすことができる。

【0010】また、本発明による放電管は、密封容器内 で一対の放電管用電極を配置させる放電管において、一 対の放電管用電極のうち少なくともいずれか一方が、前 述した放電管用電極であることを特徴とする。この放電 管によれば、密封容器内の一対の放電管用電極間に適当 な電圧を印加して放電を起こさせる際に、放電管用電極 の電極基材の表面にコーティングしたダイヤモンド薄 膜、ダイヤモンド状カーボン薄膜若しくはカーボン薄 膜、又は炭化タングステン、炭化モリブデン、炭化ハフ ニウム及び炭化タンタルからなる群より選ばれる少なく とも一種類の材料からなる膜から電子が放出され易くな り、放電時に発生する光出力の安定性が改善される。 [0011]

【発明の実施の形態】以下、図面と共に本発明による放 電管、及びその電極の好適な実施形態について詳細に説 明する。

【0012】図1は、パルス点灯型の放電管の一例とし てのキセノン・フラッシュランプの内部を示す縦断面図 であり、図2は、図1の11-11線に沿った横断面図 である。図1に示すように、フラッシュランプ1は、円 板状のガラス融着部2の外周に金属製のリング部3を取 り付けたベース部4を有している。また、フラッシュラ ンプ1は、金属からなる円筒状の包囲キャップ5を有 し、その一端に形成された開口部7には、紫外線透過性 をもった石英などからなる投光窓8が内側から気密に貼 り付けられている。そして、この包囲キャップ5の他端 に形成された開口部6に、ベース部4が気密にはめ込ま れて密封容器9が構成されている。

【0013】との密封容器9には、ガラス融着部2を貫 通する細長い円筒状の金属製排気管10を通してキセノ ンガス-(X e)-が封入されており、このキセノンガス雰_ 囲気下で、放電管用電極としての陰極11と陽極12と が互いに向き合って配置されている。また、図2に示す ように、密封容器9の内部には、針状のトリガブローブ 電極13,14が設けられ、それらの先端が、陰極11 と陽極12との間で、適当な間隔をおいて配置されてい る。また、密封容器9の内部には、スパーカ電極15が 設けられ、このスパーカ電極15は、リード線21を介 して陰極11と電気的に接続されている。

【0014】また、図1及び図2に示すように、陰極1 1及び陽極12は、これらに適当な電位を与えるため に、ガラス融着部2を貫通する陰極用ステムピン16及

リガプローブ電極13,14及びスパーカ電極15は、 ガラス融着部2を貫通するトリガプローブ電極用ステム ピン18、19及びスパーカ電極用ステムピン20の先 端にそれぞれ固定されている。

【0015】前述した構成のフラッシュランプ1におい て、陰極11と陽極12との間に適当な電圧を印加した 状態で、トリガプローブ電極13,14とスパーカ電極 15とにそれぞれ所定の周波数でトリガ電圧パルスを印 加すると、陰極11と陽極12との間にアーク放電が生 成され、投光窓8を通して外部にパルス光が放射され

【0016】図3は、図2のフラッシュランプ1に使用 される陰極11を示す側面図である。

【0017】図3に示すように、陰極11は、細長い棒 状の支持部22aの先端に円柱部22bを有し、さらに この円柱部22bの先端には、電子放出を効率的に行う べく円錐状にされた円錐部22cが設けられている。そ して、この支持部22a、円柱部22b及び円錐部22 cにより電極基材22が構成され、この電極基材22 20 は、例えば緻密な構造をもったタングステンからなる電 極母材で構成されている。電極基材22の円錐部22c 上には、0.1μm~10μm厚のダイヤモンド薄膜2 3がコーティングされ、このダイヤモンド薄膜23に は、不純物として111族の元素であるボロン(B)が ドープされてp型の不純物半導体が構成されている。な お、陰極11と同一構成を有する陽極12の円錐部に も、ボロンをドープしたダイヤモンド薄膜がコーティン グされている。

【0018】とのように、電極基材22の表面には、半 30 導体ダイヤモンド薄膜23がコーティングされているの で、陰極11と陽極12との間に適当な電圧を印加した 状態でトリガプローブ電極13,14及びスパーカ電極 15 にトリガ電圧を印加する場合に、ダイヤモンド薄膜 23中から電子が放出され易くなり、アーク放電が生成 され易くなる。このとき、放電管1の外部に時系列的に 順次放射されるパルス光の間での光強度の差が少なくな り、光出力の安定性が向上する。

【0019】また、トリガプロープ電極13,14にト リガ電圧パルスを時系列的に順次印加する場合に、トリ 40 ガ電圧パルスを印加してからパルス光が立ち上がるまで の立ち上がり時間の変動(ジッター)が小さくなる。 【0020】さらに、ダイヤモンド薄膜23にはボロン がドープされているので、ダイヤモンド薄膜23は、半 導体化されて電気伝導性を有することとなり、さらに電 子放出効率も向上する。

【0021】なお、フラッシュランプ1から放射される バルス光出力の安定性について、本実施形態のフラッシ ュランプ1に対して点灯試験を行い、この結果を、従来 からあるフラッシュランプ、すなわち電極として多孔質 び陽極用ステムビン17の先端にそれぞれ固定され、ト 50 金属製の電極本体にアルミン酸アルカリ土類を含浸させ た電極を有するものと比較を行った。ここで、光出力の 安定性とは、連続する1000ショットのパルス光出力 をシリコンフォトダイオード(図示せず)で測定する場 合に、シリコンフォトダイオードで検出される光出力の 最大値と最小値との差を最大値で割って100を掛けた ものをいう。なお、実験は、トリガ電圧パルスを100 Hzで印加し、陰極11と陽極12との間の印加電圧を 1kVとして行った。

【0022】との結果、光出力の安定性は、従来のフラ ッシュランプによれば約1.5%となり、本実施形態の 10 フラッシュランプ1によれば約0.75%となった。す なわち、本実施形態のフラッシュランプ1によれば、光 出力の安定性は、従来のフラッシュランプに比べて約2 倍に向上した。この光出力安定性の改善は、高い再現性 が要求される分析装置などの応用分野において特に有効 である。

【0023】なお、本発明による放電管は、前述した実 施形態に限定されるものではない。例えば、パルス点灯 型のフラッシュランプ1に代えて、直流点灯型の放電管 薄膜23は、陰極11にのみコーティングされる。との 直流点灯型の放電管によっても、光出力の安定性は改善 される。

【0024】また、前述した陰極11では、電極基材2 2の表面上にダイヤモンド薄膜23がコーティングされ ているが、電極基材22の表面には、カーボン薄膜又は ダイヤモンド状カーボン薄膜がコーティングされてもよ い。との場合、以下に示す効果を有する。すなわち、製 造時には、ダイヤモンド薄膜23を成膜する場合に比 べ、電極基材22を低い温度にして成膜することが可能 となり、成膜が容易になる。さらい(面積成膜が可能で あるため、製造コストの大幅な低減が可能になる。

【0025】また、前述した陰極11では、電極基材2 2の表面上にダイヤモンド薄膜23がコーティングされ ているが、電極基材22の表面には、炭化タングステ ン、炭化モリブデン、炭化ハフニウム又は炭化タンタル のうちいずれかの材料からなる膜がコーティングされて =もよい。または、電極基材2.2.の表面に、例えば炭化タ ングステンと炭化モリブデンとを融合により混合させた 混合膜をコーティングしたり、電極基材22の表面に、 炭化タングステン膜、炭化モリブデン膜を順次積層させ た積層膜をコーティングしたりしてもよい。この場合で も電極基材22の表面にダイヤモンド薄膜をコーティン グした場合と同様の効果を奏することが可能である。な お、前述した混合膜および積層膜は、炭化ハフニウムや 炭化タンタルにより構成されてもよい。

【0026】また、ダイヤモンド薄膜23中にドープす る不純物は、ボロンに限定されず、ボロン以外の111 族の元素であってもボロンの場合と同様の効果が得られ る。

【0027】また、ダイヤモンド薄膜23中にドーブす る不純物は、リン等のV族の元素であってもよい。この 場合、ダイヤモンド薄膜23はn型半導体となり、電気 伝導性を有することとなる。このため、ダイヤモンド薄 膜23のチャージアップを防止することができる。ま た、ダイヤモンド薄膜23をn型半導体とすることで、 電子放出効率を向上させることができる。さらに、電子 放出のためのしきい値エネルギーが小さくなるので、動 作時において、陰極11及び陽極12間の放電電圧ない しは電極基材22の温度を低下させることができ、ひい てはフラッシュランプ1の長寿命化を図ることができ

【0028】なお、前述したボロンドープのダイヤモン ド薄膜23を電極基材22の表面にコーティングした電 極は以下のようにして製造される。

【0029】すなわち、まず、上記電極基材22の表面 に対して公知の技術を用いて粗面化処理を行う。この粗 面化処理では、電極基材22の表面をダイヤモンド粉末 又はダイヤモンド・ペーストを用いてバフ研磨し、電極 に適用することも可能である。この場合、ダイヤモンド 20 基材22の表面を粗面化することにより行う(核発生処 理工程)。またはダイヤモンド粉末を懸濁したアルコー ル中に電極基材22を浸し、アルコール溶液に超音波を 印加することにより、電極基材22表面の粗面化処理を 行うとともできる。

> 【0030】粗面化処理を行うのは、電極基材22上で ダイヤモンドを高密度に核発生させ、短時間で連続的な ダイヤモンド薄膜23を形成するためである。なお、粗 面化の程度に特に制限はないが、上記の処理では局所的 な粗度で500A以下、マクロな凹凸は約10μm以下 30 にできる。

【0031】ダイヤモンド薄膜23を電極基材22の表 面にコーティングするには(気相合成工程)、マイクロ 波CVD法、高周波プラズマCV D法、熱フィラメント CVD法、直流プラズマCVD法、プラズマジェット 法、燃焼法、熱CVD法など公知の合成技術を用いると とができる。

【0032】マイクロ波CVD法の場合の典型的な合成 条件は、水素希釈のメタン0.5~10%、ジボラン

(B₁H₆) 0. 5~100ppm、原料ガスの圧力10 40 Torr~1気圧、基板温度(電極基材の温度)600 ~1000℃である。マイクロ波照射により発生するプ ラズマ中に電極基材22が接触するか、プラズマに電極 基材22が包まれるように電極基材22を設置すること により、電極基材22表面にダイヤモンドが成長する。 さらに0.05~10%の酸素を添加することにより膜 質を向上させることもできる。メタンの代わりに一酸化 炭素を用いたり、メタン・一酸化炭素の混合ガスを用い るととも公知である。上記の条件におけるp型半導体ダ イヤモンド薄膜の成長速度は0.1~0.5 μm/hで 50 あり、合成条件や合成時間を変えることにより、ダイヤ

8

モンド薄膜の膜厚を制御できる。

【0033】上記の粗面化処理を行う休わりに、いわゆるバイアス核発生技術を用いることもできる。この場合、水素ガス及びヘリウムガスからなる混合処理ガスを反応室に導入してマイクロ波によりプラズマを発生させ、電極基材22の表面を十分に清浄化する。ただし、この処理は省略することもできる。

【0034】つぎに、電極基材22の表面を炭素過飽和な状態とする表面処理を行う(表面処理工程)。この・後、電極基材22の表面にダイヤモンド核発生を行う(核発生工程)。まず、反応室又は反応室に挿入したバイアス印加用電極をアースし、これに対して電極基材22に-50~-200Vの電位を与える。反応室には水素で希釈したメタンガスを導入し、マイクロ波を印加してプラズマを発生させ、一定時間(1~20分間)保持する。この後、上記気相合成工程と同じ条件でダイヤモンド薄膜を気相合成する。

【0035】なお、核発生工程で電極基材22に印加するバイアス電圧は、負であっても正であっても良いが、 負であることが好ましい。これは正とした場合より負と した方が炭素原子を含むイオンが引きつけられ易く、電 極基材22の表面がより速やかに炭素過飽和な状態になるからである。

【0036】また、リンをドープしたダイヤモンド薄膜を電極基材表面にコーティングする場合には、前述した気相合成工程において、ジボランに代えて0.1~20ppmのフォスフィン(PH,)を用いる。同様の条件 *

* で窒素ガスまたはアンモニアガスを添加すれば、窒素ドープされたダイヤモンド薄膜を合成できる。

【0037】また、ダイヤモンド薄膜23を電極基材22にコーティングするにあたって、タングステンからなる電極母材にあらかじめモリブデンをコーティング(膜厚は $0.01\sim10\,\mu\mathrm{m}$)しておけば、電極母材であるタングステンに何もコーティングしない場合に比べて、タングステンとダイヤモンドとの密着性を大幅に向上させることができる。

10 [0038]

【発明の効果】以上説明したように本発明による放電管 および放電管用電極は、電極基材の表面にダイヤモンド 薄膜、ダイヤモンド状カーボン薄膜又はカーボン薄膜を コーティングすることにより、放電時に発生する光出力の安定性を改善することができる。この光出力の安定性の改善は、高い再現性が要求される分析装置などの応用分野において特に有効である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による放電管の好適な実施形態を示す縦) 断面図である。

【図2】図1の11-11線に沿った横断面図である。

【図3】本発明による放電管用電極の好適な実施形態を 示す側面図である。

【符号の説明】

1…フラッシュランプ(放電管)、11…陰極(放電管 用電極)、12…陽極(放電管用電極)、22…電極基 材、23…ダイヤモンド薄膜。

